Справ. №						Перв. застосув.						
Формат	Зона	Позиція		1.ЧЕННЯ	РННЯ		Наймел	нування	7	Kin.	Примі– тки	
								Докум	ентація	,		
A4			ДК82.469338.001 ПЕЗ				Захист телефона від піратів. Перелік елементів				1	
A2			ДК82.469338.001 E3				Захист телефона від піратів. Схема електрична принципова				1	
A2	ДК82.750706.001 СК				Плата. Складальне креслення			еслення	1			
					<u>Деталі</u>							
A2		1	ДК82.758	,		Плата д	рукова	ΊΗΩ		1		
								Інші ц	<u>βυροδυ</u>			
		2 3			<u>Діоди</u>							
					1N4148W Yangjie BZX384 NXP				5	VD3-VD7		
									2	VD1,VD2		
					<u>Конденсатори</u>			1				
					C-0805 50 B 1mkΦ 10% X7R							
		4					L-U8U5 .	50 B 11	ΜΚΦ 1U%	% X7R	3	<i>C1-C3</i>
							1					
		<del> </del>					ΠΚΟΊ	75	<u></u> 7704	( 001	$\Gamma$	
Зм.			№ докум. Підп. Дата			ДК82	/Jl	J / UC				
Розроб. Перев.			Ниш Е. Р. Адаменко I.O.							Аркуи 1	и Аркушів З	
	Н.контр. Затв.		Губар В.Г.			[[				л. I.Сікорського, I. KEOA, ДК–82		
	1.2 NO2-					<i>D</i>	т. інв. N°	1 Q	N/0 ⊒⋝ -		Піда	а дата
Інв. № подл. Підп. та дата Взі						IM. IHU. IV	IHŪ.	№ дубл.	/	ווטוו. ווו	ע טעוווע	

Формат	Зона	Ярпер	Позначення	Найменування	Kir.	Примі- тка				
				<u>Мікросхеми</u>						
		5		74AC191SC Fairchild	4	DD8,DD9				
						DD12,DD13				
		6		74HC86D Philips	1	DD1				
		7		74HCT74PW NXP	1	DD2				
		8		CD4061A NXP	1	DD10				
		9		CD74ACO2M96 TI						
		10		SN74HC10QDREP Texas Instruments	4	DD4,DD7				
						<i>DD11,DD14</i>				
		11		TC74ACO4F Toshiba	2	DD5,DD6				
		12		КР1014КТ1А Электроника и связь	1	DA1				
				<u>Резистори</u>						
		13		R-0805 0,125 Вт 39 кОм 5 %	1	R4				
		14		R-0805 0,125 Вт 76,5 кОм 5	1	R3				
		15		2	R6,R7					
		16		R-0805 0,125 Вт 100 кОм 5	4	R5,R8-R10				
		17		R-0805 0,125 Вт 390 кОм 5	1	R1				
		18		1	R2					
		<u>Pas</u>		<u>Роз'еми</u>						
		19		PLS–2 Ningbo Zhenqin Electronic	3	XP1-XP3				
Зм.	A	DK.	№ докум. Підп. Дата	ДК82.750706.001 С	77	Арк. 2				
			2 1 1 7			<b>I</b>				
	Інв.	Nº ⊓C	пдл. Підп. та дата	Взам. інв. № Інв. № дубл.	Підп. т	Тідп. та дата				

Формат	Зона	<i>Р</i> іриє0П	Позначення	Найменування			Кіл.	Примі– тка		
						<u>Транзистори</u>				
		20			L	BC856B Infineon		1	VT1	
						<u>Матеріали</u>				
		21			ΠΟΣ	61	76	122		
					<u> </u>					
	ДК82.750706.001 СП 3									
Зм.	A	DK.	№ докум. Підп. Дата		1102./	JU / UU.UL	)	/	3	
	Інв. № подл. Підп. та дата			Взам. інв. № Інв. № дубл. Підп. та да				л дата		